PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-356383

(43) Date of publication of application: 13.12.2002

(51)Int.CI.

CO4B 38/00 B01D 39/00 B01D 39/20 B01D 53/86 B01J 27/224 B01J 32/00 B01J 35/04

CO4B 35/565

(21)Application number : 2002-061989

(71)Applicant: NGK INSULATORS LTD

(22)Date of filing:

07.03.2002

(72)Inventor: TOMITA TAKAHIRO

TABUCHI YUICHIRO **ICHIKAWA SHUICHI**

HARADA SETSU

(30)Priority

Priority number: 2001102008 Priority date: 30.03.2001 Priority country: JP

(54) SILICON CARBIDE BASED POROUS COMPACT AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a silicon carbide based porous compact and a method for manufacturing the same which is high in porosity, high in thermal conductivity, moreover heighten in strength, as well as capable of producing with a low cost.

SOLUTION: The silicon carbide based porous compact consists of silicon carbide grain and metallic silicon to be an aggregate. A mean pore diameter of silicon carbide based porous compact is larger than a mean grain diameter of silicon carbide grains by ≥2.5 times. The silicon carbide based porous compact is manufactured by forming a material obtained by mixing and kneading a raw material of silicon carbide grain, metallic silicon and an organic binder, into predetermined shape, the obtained compact is preliminary fired to eliminate organic binder in the compact, then the compact is normally fired.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

09.07.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-356383 (P2002-356383A)

最終頁に続く

(43)公開日 平成14年12月13日(2002.12.13)

								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		A *
(51) Int.Cl.7		識別記号		FI			テーマコート*(参考)			
C 0 4 B	38/00	3 0 4		C 0 4 B 38/00			304Z	4D019	•	
		303						3 0 3 Z	4D048	3
B01D	39/00			B 0 1	D 3	39/00		В	4G001	l
	39/20	•		39/20		D	4G019			
	53/86			B 0 1	J 2	27/224		Α	4G069	•
			来讀查審	未請求	青求!	項の数24	OL	(全 12 頁)	最終頁に	に続く
(21)出願番号(22)出顧日		特願2002-61989(P2002-	(P2002-61989)		(71) 出願人 000004064					
		平成14年3月7日(2002.3.7)		日本碍子株式			会社 市瑞穂区須田町2番56号			
		TACIST 0 /3 / LI (2002. 3. 1/		(72)発明者 富田 崇弘			印物物区次田	四 2 倍 30 万		
(31)優先権主張番号		特願2001-102008(P2001-	-102008)		,,,,			市瑞穂区須田	町2番56号	目
(32)優先日		平成13年3月30日(2001.3	.30)			本碍子	株式会	社内		
(33)優先権主張国		日本(JP)		(72)発明者 田渕 雄一郎		雄一郎				
						愛知県	名古屋	市瑞穂区須田	町2番56号	目
						本碍子	株式会	社内		
				(74)代	理人	100088	616			
						1	渡邉			

(54) 【発明の名称】 炭化珪素質多孔体及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】 安価に製造できるとともに高気孔率、高熱伝 導率であり、且つ、強度向上のなされた炭化珪素質多孔 体とその製造方法を提供する。

【解決手段】 骨材となる炭化珪素粒子と、金属珪素とを含む炭化珪素質多孔体である。炭化珪素質多孔体の平均気孔径が、炭化珪素粒子の平均粒子径の0.25倍以上である。この炭化珪素質多孔体は、炭化珪素粒子原料に、金属珪素と有機バインダーを添加し混合及び混練して得られた坏土を所定形状に成形し、得られた成形体を仮焼して成形体中の有機バインダーを除去した後、減圧雰囲気下で本焼成することにより製造する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 骨材となる炭化珪素粒子と、金属珪素と を含む炭化珪素質多孔体であって、

該炭化珪素質多孔体の平均気孔径が、該炭化珪素粒子の平均粒子径の0.25倍以上であることを特徴とする炭化珪素質多孔体。

【請求項2】 骨材となる炭化珪素粒子と、金属珪素とを含む炭化珪素質多孔体であって、

該炭化珪素粒子と該金属珪素との接触角が鋭角であると とを特徴とする炭化珪素質多孔体。

【請求項3】 骨材となる炭化珪素粒子と、金属珪素と を含む炭化珪素質多孔体であって、

一の該金属珪素に対して、四以上の該炭化珪素粒子が接触することにより形成された多数の二次組織粒子が相互に結合することにより、多孔質構造が形成されていることを特徴とする炭化珪素質多孔体。

【請求項4】 一の該二次組織粒子に含まれる該炭化珪素粒子の個数が、該炭化珪素質多孔体に含まれる該炭化珪素粒子の個数の30%以上である請求項3に記載の炭化珪素質多孔体。

【請求項5】 骨材となる炭化珪素粒子と、金属珪素とを含む炭化珪素質多孔体であって、

該炭化珪素粒子と該金属珪素との界面面積が、該界面面積と、該金属珪素の表面積とを合わせた面積の50%以上であることを特徴とする炭化珪素質多孔体。

【請求項6】 該炭化珪素粒子及び/又は該金属珪素の表面又は周辺に、非晶質又は結晶質の珪酸塩化合物相を有する請求項1~5のいずれか一項に記載の炭化珪素質多孔体。

【請求項7】 該炭化珪素粒子どうしが、該金属珪素及 30 び/又は該珪酸塩化合物相により結合している請求項6 に記載の炭化珪素質多孔体。

【請求項8】 該珪酸塩化合物相は、珪素以外の一種以上の金属元素と二酸化珪素とを含むものであり、一種以上の該金属元素と、該二酸化珪素との共融点が1200~1600℃である請求項6又は7に記載の炭化珪素質多孔体。

【請求項9】 該珪酸塩化合物相は、珪素以外の一種以上の金属元素と二酸化珪素とを含むものであり、一種以上の該金属元素の、該炭化珪素粒子と該金属珪素との合 40計に対する含有率が0.1~10質量%である請求項6~8のいずれか一項に記載の炭化珪素質多孔体。

【請求項10】 一種以上の該金属元素のうち、少なくとも一種がアルカリ土類金属元素である請求項8又は9 に記載の炭化珪素質多孔体。

【請求項11】 一種以上の該金属元素として、アルカリ土類金属元素以外の金属元素を更に含有する請求項1 0 に記載の炭化珪素質多孔体。

【請求項12】 該アルカリ土類金属元素がカルシウム、及び/又はストロンチウムである請求項10又は1 50

1 に記載の炭化珪素質多孔体。

【請求項13】 該金属珪素の、該炭化珪素粒子と該金属珪素との合計に対する含有率が5~50質量%である請求項1~12のいずれか一項に記載の炭化珪素質多孔体。

【請求項14】 請求項1~13のいずれか一項に記載の炭化珪素質多孔体により構成されることを特徴とするハニカム構造体。

【請求項15】 炭化珪素粒子原料に、金属珪素と有機 10 バインダーを添加し混合及び混練して得られた坏土を所 定形状に成形し、得られた成形体を仮焼して該成形体中 の該有機バインダーを除去した後、減圧雰囲気下で本焼 成することを特徴とする炭化珪素質多孔体の製造方法。

【請求項16】 炭化珪素粒子原料に、金属珪素と有機バインダーを添加し混合及び混練して得られた坏土を所定形状に成形し、得られた成形体を仮焼して該成形体中の該有機バインダーを除去した後、水素を含有する還元雰囲気下で本焼成することを特徴とする炭化珪素質多孔体の製造方法。

20 【請求項17】 炭化珪素粒子原料に、金属元素又は該金属元素を含む化合物、金属珪素、及び有機バインダーを添加し、混合及び混練して得られた坏土を所定形状に成形し、得られた成形体を仮焼して該成形体中の該有機バインダーを除去した後、非酸化雰囲気下で本焼成することを特徴とする炭化珪素質多孔体の製造方法。

【請求項18】 二酸化珪素との共融点が1200~1600℃である該金属元素を用いる請求項17に記載の 炭化珪素質多孔体の製造方法。

【請求項19】 該金属元素としてアルカリ土類金属元素を用いる請求項17又は18に記載の炭化珪素質多孔体の製造方法。

【請求項20】 該アルカリ土類金属元素としてカルシウム、及び/又はストロンチウムを用いる請求項19に記載の炭化珪素質多孔体の製造方法。

【請求項21】 該金属元素を含む化合物としてフッ化物、炭化物、塩化物、珪化物、炭酸塩、水酸化物、酸化物、無機酸塩、有機酸塩からなる群より選択される少なくとも一種を用いる請求項17~20のいずれか一項に記載の炭化珪素質多孔体の製造方法。

40 【請求項22】 該無機酸塩として珪酸塩を用いる請求 項21に記載の炭化珪素質多孔体の製造方法。

【請求項23】 該坏土をハニカム形状に成形する請求項15~22のいずれか一項に記載の炭化珪素質多孔体の製造方法。

【請求項24】 1300~1600℃の温度範囲で本 焼成する請求項15~23のいずれか一項に記載の炭化 珪素質多孔体の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】 本発明は、自動車排気ガス

浄化用のフィルターや触媒担体等に使用される炭化珪素 質多孔体、及びその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】 ディーゼルエンジン排気ガスのような 含塵流体中に含まれる粒子状物質を捕集除去するための フィルター、又は排気ガス中の有害物質を浄化する触媒 成分を担持するための触媒担体として、多孔質のハニカ ム構造体が広く使用されている。また、このようなハニ カム構造体の構成材料として、炭化珪素(SiC)粒子 のような耐火性粒子を使用することが知られている。

【0003】 具体的な関連技術として、例えば特開平 6-182228号公報には、所定の比表面積と不純物 含有量を有する炭化珪素粉末を出発原料とし、これを所 望の形状に成形、乾燥後、1600~2200℃の温度 範囲で焼成して得られるハニカム構造の多孔質炭化珪素 質触媒担体が開示されている。

【0004】 また、特開平10-310474号公報 には、所定量のCa又はCa化合物を含有し、高温アル カリガス雰囲気に耐久性を示すSiC-Si複合セラミ ックス材が開示されている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】 前記特開平6-18 2228号公報に示される、炭化珪素粉末自体の再結晶 反応による焼結形態(ネッキング)では、炭化珪素粒子 表面から炭化珪素成分が蒸発し、これが粒子間の接触部 (ネック部)に凝縮することで、ネック部が成長し結合 状態が得られるが、炭化珪素を蒸発させるには、非常に 高い焼成温度が必要であるため、これがコスト高を招 き、且つ、熱膨張率の高い材料を高温焼成しなければな った。

【0006】 また、特開平10-310474号公報 に示されるSiC-Si複合セラミックス材を製造する にあたっても、1800~2000℃といった高温で焼 成する必要がある。更に、とのSiC-Si複合セラミ ックス材は、主にるつぼ等の焼成容器として用いられる 緻密な材料であるために、多孔質フィルター用の材料と しては採用することはできない。

【0007】 上記問題点を解消すべく、本発明者らは 耐火性粒子、特に炭化珪素と金属珪素を含む多孔質ハニ カム構造体、及びその製造方法を提示している。当該出 願においては、比較的低い焼成温度で安価に製造できる とともに、熱伝導率が高く、十分に多孔質かつ高比表面 **積であるハニカム構造体が提示されている。**

【0008】 ただし、特願2001-32699明細 書において示された製造方法であっても、場合によって は問題を生ずることも想定される。図4は、従来の炭化 珪素質多孔体の微細構造における炭化珪素粒子と金属珪

1上に金属珪素2が接触し、両者の表面が酸化皮膜3に より覆われた状態を示している。なお、ここでいう酸化 皮膜3とはSiO₂等である。前記製造方法に従って焼 成を行うと、溶融した金属珪素2と炭化珪素粒子1との 濡れ性が良好ではない場合があり、得られる炭化珪素質 多孔体においては、炭化珪素粒子1上の酸化皮膜3と金 属珪素2上の酸化皮膜3との接触角θは鈍角となってい る。即ち、金属珪素2が炭化珪素粒子1に対してはじか れたような組織構造を有しており、両者の接触面積が小 10 さくなっている場合がある。

【0009】 とのように、前述の接触面積が小さくな っている場合には、炭化珪素質多孔体自体の強度が低下 してしまい、また、熱伝導のバスも細いために熱伝導率 も低下してしまうといった問題が生ずることが想定され る。

【0010】 一方、製造される炭化珪素質多孔体の気 孔径は、骨材である炭化珪素粒子の粒子径に依存する。 即ち、気孔径が大きい炭化珪素質多孔体を得るために は、より大きな粒子径を有する炭化珪素粒子を使用する 20 ことが一般的である。しかし、粒子径の大きい炭化珪素 粒子を用いると、成形が困難となる場合がある。また、 ハニカム形状等に押出成形する場合においては、成形用 の口金の磨耗も顕著となるために、製造コスト増加等の 問題が生ずる恐れもある。即ち、炭化珪素粒子の粒子径 を選択することによって、炭化珪素質多孔体の気孔率を 制御し、気孔径を大径化する方法には、技術的、製造コ スト的な限界がある。

【0011】 本発明は、このような従来技術の有する 問題点に鑑みてなされたものであり、その目的とすると らないために、焼成歩留まりが低下するという問題があ 30 ころは、安価に製造できるとともに高気孔率、高熱伝導 率であり、且つ、強度向上のなされた炭化珪素質多孔体 とその製造方法を提供することにある。

[0012]

【課題を解決するための手段】 即ち、本発明によれ ば、骨材となる炭化珪素粒子と、金属珪素とを含む炭化 珪素質多孔体であって、該炭化珪素質多孔体の平均気孔 径が、該炭化珪素粒子の平均粒子径の0.25倍以上で あることを特徴とする炭化珪素質多孔体が提供される。 【0013】 一方、本発明によれば、骨材となる炭化 特願2001-32699明細書において、骨材である 40 珪素粒子と、金属珪素とを含む炭化珪素質多孔体であっ て、該炭化珪素粒子と該金属珪素との接触角が鋭角であ ることを特徴とする炭化珪素質多孔体が提供される。 【0014】 また、本発明によれば、骨材となる炭化 珪素粒子と、金属珪素とを含む炭化珪素質多孔体であっ て、一の該金属珪素に対して、四以上の該炭化珪素粒子 が接触することにより形成された多数の二次組織粒子が 相互に結合することにより、多孔質構造が形成されてい ることを特徴とする炭化珪素質多孔体が提供される。な お、本発明においては、一の二次組織粒子に含まれる炭 素との接触状態を説明する模式図であり、炭化珪素粒子 50 化珪素粒子の個数が、炭化珪素質多孔体に含まれる炭化

珪素粒子の個数の30%以上であることが好ましい。

【0015】 更に、本発明によれば、骨材となる炭化 珪素粒子と、金属珪素とを含む炭化珪素質多孔体であっ て、該炭化珪素粒子と該金属珪素との界面面積が、該界 面面積と、該金属珪素の表面積とを合わせた面積の50 %以上であることを特徴とする炭化珪素質多孔体が提供 される。

【0016】 本発明においては、炭化珪素粒子及び/ 又は金属珪素の表面又は周辺に、非晶質又は結晶質の珪 酸塩化合物相を有することが好ましく、炭化珪素粒子ど うしが、金属珪素及び/又は珪酸塩化合物相により結合 していることが好ましい。また、珪酸塩化合物相は、珪 素以外の一種以上の金属元素と二酸化珪素とを含むもの であり、一種以上の金属元素と二酸化珪素との共融点が 1200~1600℃であることが好ましく、更に、一 種以上の金属元素の、炭化珪素粒子と金属珪素との合計 に対する含有率が0.1~10質量%であることが好ま しい。

【0017】 更に、本発明においては、一種以上の金属元素のうち、少なくとも一種がアルカリ土類金属元素であることが好ましく、一種以上の金属元素として、アルカリ土類金属元素以外の金属元素を更に含有することが好ましい。また、アルカリ土類金属元素がカルシウム、及び/又はストロンチウムであることが好ましい。なお、本発明においては、金属珪素の、炭化珪素粒子と金属珪素との合計に対する含有率が5~50質量%であることが好ましい。

【0018】 また、本発明によれば、上記いずれかの 炭化珪素質多孔体により構成されることを特徴とするハ ニカム構造体が提供される。

【0019】 一方、本発明によれば、炭化珪素粒子原料に、金属珪素と有機バインダーを添加し混合及び混練して得られた坏土を所定形状に成形し、得られた成形体を仮焼して該成形体中の有機バインダーを除去した後、減圧雰囲気下で本焼成することを特徴とする炭化珪素質多孔体の製造方法が提供される。

【0020】 また、本発明によれば、炭化珪素粒子原料に、金属珪素と有機バインダーを添加し混合及び混練して得られた坏土を所定形状に成形し、得られた成形体を仮焼して該成形体中の有機バインダーを除去した後、水素を含有する還元雰囲気下で本焼成することを特徴とする炭化珪素質多孔体の製造方法が提供される。

【0021】 本発明によれば、炭化珪素粒子原料に、 金属元素又は該金属元素を含む化合物、金属珪素、及 び、有機バインダーを添加し、混合及び混練して得られ た坏土を所定形状に成形し、得られた成形体を仮焼して 該成形体中の有機バインダーを除去した後、非酸化雰囲 気下で本焼成することを特徴とする炭化珪素質多孔体の 製造方法が提供される。

【0022】 本発明においては、二酸化珪素との共融 50 徴を有する本発明に係る炭化珪素質多孔体の製造方法に

点が1200~1600℃である金属元素を用いることが好ましく、また、金属元素としてアルカリ土類金属元素を用いることが好ましい。更には、アルカリ土類金属元素としてカルシウム、及び/又はストロンチウムを用いることが好ましく、金属元素を含む化合物としてフッ化物、炭化物、塩化物、珪化物、炭酸塩、水酸化物、酸化物、無機酸塩、有機酸塩からなる群より選択される少なくとも一種を用いることが好ましい。なお、無機酸塩として珪酸塩を用いることが好ましい。

【0023】 本発明においては、坏土をハニカム形状に成形することが好ましく、1300~1600℃の温度範囲で本焼成することが好ましい。

[0024]

(4)

【発明の実施の形態】 以下、本発明の実施の形態について説明するが、本発明は以下の実施の形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、当業者の通常の知識に基づいて、適宜、設計の変更、改良等が加えられることが理解されるべきである。

【0025】 本発明の炭化珪素質多孔体は、骨材となる炭化珪素粒子と、金属珪素とを含んでいるので、その製造時において比較的低い焼成温度で焼結することができ、製造コストを抑えるとともに歩留まりを向上させることができる。また、耐火性粒子である炭化珪素粒子の結合に金属珪素を利用したことにより、高い熱伝導率を有するので、例えばDPF(ディーゼル パティキュレート フィルター)に使用した場合において、フィルター再生のために堆積したパティキュレートを燃焼させても、フィルターを損傷させるような局所的な温度上昇が生じない。

30 【0026】 また、本発明の炭化珪素質多孔体は、その平均気孔径(以下、単に「気孔径」と記す。)が、当該炭化珪素質多孔体の構成要素の一つである炭化珪素粒子の平均粒子径(以下、単に「粒子径」と記す。)の0.25倍以上であることが必要であり、0.40倍以上であることが好ましく、0.50倍以上であることが更に好ましい。気孔径の大きさを当該数値に規定することにより、より高気孔率、高熱伝導率等の特性を有する炭化珪素質多孔体とすることが可能である。

【0027】 なお、気孔径が炭化珪素粒子の粒子径の 40 0.25倍未満である場合、ある程度大きな気孔径を得 ようとすると、用いる炭化珪素粒子の粒径が大きくなる ため、成形性が不良となることがある。例えば、ハニカ ム形状等に押出成形する際に用いる口金の磨耗が顕著と なることがあるために好ましくない。

【0028】 ことで、本発明においては、前記数値の上限は特に限定されるものではなく、同一サイズの気孔径であれば、炭化珪素粒子の粒子径は小さいほど好ましい。ただし、実質的な製造条件等を考慮すれば、概ね5.0倍未満であれば良い。なお、前述ような構造的特徴を存まる本発明に係る岩化珪素関タスはの製造支法に

(5)

ついては後述する。

【0029】 本発明の炭化珪素質多孔体は、炭化珪素 粒子と金属珪素との接触角が鋭角であることを特徴とし ている。図1は、本発明の炭化珪素質多孔体の微細構造 における炭化珪素粒子と金属珪素との接触状態の一例を 説明する模式図であり、炭化珪素粒子 1 上に金属珪素 2 が接触した状態を示している。即ち、本発明の炭化珪素 質多孔体においては、炭化珪素粒子1と金属珪素2との 接触角θが鋭角であり、溶融した金属珪素2と炭化珪素 粒子1との濡れ性が改善されている。従って、本発明の 10 炭化珪素質多孔体は、両者の接触面積が大きくなってい るために、より高強度、高熱伝導率等の特性を有する。 なお、このような構造的特徴を有する本発明に係る炭化 珪素質多孔体の製造方法については後述する。

7

【0030】 とこで「接触角」とは、通常、固体と液 体との接触によって形成される角度を示すために用いら れている語であるが、本発明においては、どちらも固体 である場合に用いるものとする。即ち、炭化珪素粒子と 金属珪素との接触点で金属珪素に引いた接線と、炭化珪 素粒子の表面のなす角度のうち、金属珪素を含む角度θ のことを「接触角」というものとする。なお、図4に示 すような従来の炭化珪素質多孔体の微細構造の場合に は、炭化珪素粒子1上の酸化皮膜3と、金属珪素2上の 酸化皮膜3との接触点で、金属珪素に引いた接線と、炭 化珪素粒子1上の酸化皮膜3表面のなす角度のうち、金 属珪素を含む角度のことを「接触角」というものとす る。

【0031】 本発明の炭化珪素質多孔体は、一の金属 珪素に対して、四以上の炭化珪素粒子が接触することに より形成された多数の二次組織粒子(以下、「ドメイ ン」と記す。)が相互に結合することにより、多孔質構 造が形成されていることを特徴としている。即ち、ドメ イン同士が相互に連結して多孔質構造を形成するために 結合部分が太くなり、高強度、高熱伝導率等の特性を有 する。

【0032】 また、例えばDPFに使用した場合にお いても局所的温度上昇が生じ難く、耐熱衝撃性にも優れ ている。また、ドメイン同士の間隙によって気孔が形成 されるために、炭化珪素粒子と金属珪素との接触角が鈍 角である場合に比して気孔が大径化されており、フィル 40 ターとして使用するに際して圧力損失を低くすることが できる。

【0033】 更に、本発明において気孔径はドメイン の大きさに依存する。即ち、用いる炭化珪素粒子の粒子 径によって気孔径を制御する必要がなく、比較的小さな 粒子径を有する炭化珪素粒子を使用しても、気孔を大径 化することが可能である。従って、ハニカム形状等に押 出成形する場合であっても、成形性が良好であり、口金 の磨耗等の不具合も抑制されるために、製造歩留まりの 向上や設備コストの低減が可能である。なお、前述よう 50 酸塩化合物相を有することが好ましい。図2は、本発明

な構造的特徴を有する本発明に係る炭化珪素質多孔体の 製造方法については後述する。

【0034】 更に、本発明においては、一の二次組織 粒子に含まれる炭化珪素粒子の個数が、炭化珪素質多孔 体に含まれる炭化珪素粒子の個数の30%以上であると とが好ましい。30%未満である場合には、炭化珪素粒 子と金属珪素との接触面積の拡大効果が不十分であり、 強度や熱伝導率等の顕著な向上が認められないために好 ましくない。

【0035】 なお、より髙気孔率、髙熱伝導率等の特 性が付与されるためには、35%以上であることが更に 好ましく、40%以上であることが特に好ましい。ま た、本発明においては前記数値の上限は特に限定される ものではなく、全ての炭化珪素粒子が二次組織粒子に含 まれることが好ましい。ただし、実質的な製造条件等を 考慮すれば、概ね90%未満であれば良い。

【0036】 一方、本発明によれば、炭化珪素粒子と 金属珪素との界面面積が、界面面積と金属珪素の表面積 とを合わせた面積の50%以上である必要があり、65 %以上であることが好ましく、80%以上であることが 更に好ましい。界面面積を当該数値割合に規定すること により、より高気孔率、高熱伝導率等の特性を有する炭 化珪素質多孔体とすることが可能である。なお、前記数 値が50%未満である場合には、炭化珪素粒子と金属珪 素との接触面積の拡大効果が不十分であり、強度や熱伝 導率等の顕著な向上が認められないために好ましくな

【0037】 ここで、本発明においては、前記数値の 上限は特に限定されるものではなく、炭化珪素粒子と金 30 属珪素との界面面積が、界面面積と金属珪素の表面積と を合わせた面積の95%以上であることが好ましい。た だし、実質的な製造条件等を考慮すれば、概ね90%未 満であれば良い。なお、前述のような構造的特徴を有す る本発明に係る炭化珪素質多孔体の製造方法については 後述する。

【0038】 なお、本発明でいう、炭化珪素粒子と金 属珪素との界面面積と金属珪素の表面積を合わせた面積 に対する、炭化珪素粒子と金属珪素との界面面積の割合 (以下、単に「界面面積の割合」という。)は、以下の 方法によって算出する。まず、対象となる炭化珪素質多 孔体を樹脂に埋め込み、研磨して、内部断面を得る。と れを走査型電子顕微鏡により観察し、その観察写真の画 像解析を行う。得られた解析写真をもとにして、炭化珪 素粒子と金属珪素との界面曲線と、金属珪素表面の曲線 の長さを測定し、界面曲線の長さと金属珪素表面の曲線 の長さとの和に対する、界面曲線の長さの割合を、界面 面積の割合とする。

【0039】 本発明においては、炭化珪素粒子及び/ 又は金属珪素の表面又は周辺に、非晶質又は結晶質の珪 (6)

の炭化珪素質多孔体の微細構造における炭化珪素粒子と 金属珪素との接触状態の別の例を説明する模式図であ り、炭化珪素粒子1と金属珪素2の表面が、珪酸塩化合 物相4により被覆された状態を示している。添加した金 属元素の作用により、炭化珪素および金属元素表面の酸 化膜は濡れ性に悪影響を及ぼさないような珪酸塩化合物 相4を生成する。その結果、珪酸塩化合物相4は炭化珪 素粒子1と金属珪素2との濡れ性を改善する効果を示す ために、両者の接触面積が拡大される。なお、珪酸塩化 合物相4の含有量が増加するに従い、炭化珪素質多孔体 10 の熱伝導率は低下する。即ち、本発明の炭化珪素質多孔 体は、珪酸塩化合物相の含有量により所望の熱伝導率を 示すものであり、この含有量は適宜調整可能である。従 って、本発明の炭化珪素質多孔体は、より高気孔率、高 強度であるとともに、その熱伝導率をはじめとする熱的 特性が任意に調整され得るものである。

【0040】 本発明においては、炭化珪素粒子どうしが、金属珪素及び/又は珪酸塩化合物相により結合していることが好ましい。図9は、本発明の炭化珪素質多孔体の微細構造を説明する模式図であり、炭化珪素粒子1どうしが金属珪素2や珪酸塩化合物相4によって相互に結合し、気孔10を形成した状態を示している。即ち、本実施形態の炭化珪素質多孔体は、炭化珪素粒子1どうしが金属珪素2により結合している状態(図9

(a)、炭化珪素粒子1どうしが金属珪素2、又は金属珪素2と珪酸塩化合物相4により結合している状態(図9(b))、炭化珪素粒子1どうしが金属珪素2、炭化珪素粒子1と珪酸塩化合物相4、珪酸塩化合物相4により結合している状態(図9(c))のいずれの状態であってもよい。これらのような微細構造とすることに30より、本発明の炭化珪素質多孔体は高気孔率、高強度であるとともに、その熱伝導率をはじめとする熱的特性が任意に調整され得る。なお、図9(a)~(c)において示した微細構造は例示であって、本発明はこれらの例示に限定されるものではなく、例えば、炭化珪素粒子どうしが結合しておらず、単独の炭化珪素粒子に金属珪素及び/又は珪酸塩化合物相が付着した状態の箇所が部分的に含まれていてもよい。

【0041】 更に、本発明においては、珪酸塩化合物相、珪素以外の一種以上の金属元素と二酸化珪素とを含 40 むものであり、一種以上の金属元素と二酸化珪素との共融点が1200~1600℃であることが、より効果的な濡れ性改善を図るために好ましい。1200℃未満である場合には、MO-(M₁O-、M₂O-、…)SiO₂系(M、M₁、M₂、…は一種以上の金属元素を示す。)の融液が金属珪素が溶融する焼成温度付近で残存せず、焼成時に前述の濡れ性の改善、及び接触面積拡大効果が発現し難いために好ましくない。一方、1600℃超である場合には、焼成時にMO(M₁O、M₂O、…)とSiO₂との反応が十分に進まず、前述の濡れ性 50

の改善、及び、接触面積拡大効果が発現し難いために好ましくない。

【0042】 また、本発明においては、前述の一種以上の金属元素の、炭化珪素粒子と金属珪素との合計に対する含有率が0.1~10質量%であることが好ましく、0.2~7質量%であることが更に好ましく、0.3~5質量%であることが特に好ましい。一種以上の金属元素の含有率を前記数値範囲とすることにより、炭化珪素粒子と金属珪素との濡れ性が改善されるという効果を示すこととなる。なお、0.1質量%未満である場合には、金属元素の効果が発揮されず、また、10質量%超である場合には、生成する珪酸塩化合物相の量が多くなりすぎであり、熱膨張率が著しく増大する場合もあるために好ましくない。

【0043】 本発明においては、前記一種以上の金属元素のうち、少なくとも一種がアルカリ土類金属元素であることが好ましく、一種以上の金属元素として、アルカリ土類金属元素以外の金属元素を更に含有することが好ましい。このことにより、炭化珪素粒子と金属珪素との濡れ性が効果的に改善され、より、高気孔率である等の特性を有する炭化珪素質多孔体とすることが可能である。

【0044】 なお、アルカリ土類金属元素以外の金属元素としては、アルカリ土類金属と3成分以上の系を形成するとともに、この系の共融点が1200~1600 ℃となるものであればよく、具体例としてA1、Ti、Fe等を挙げることができる。更に、3成分以上の系の具体例としてMg-A1-Si、Sr-A1-Si、Ba-A1-Si、Ca-A1-Si、又はCa-Mg-Si系等を挙げることができる。また、安価で入手容易であるとともに、濡れ性改善等の観点からは、前記アルカリ土類金属元素がカルシウム、及び/又はストロンチウムであることが好ましい。

【0045】 更に、本発明においては、金属珪素の、 炭化珪素粒子と金属珪素との合計に対する含有率が5~ 50質量%であることが好ましい。金属珪素の含有率を 前記数値範囲内とすることにより、金属珪素を含まない 従前の炭化珪素質多孔体に比して、低温で焼成すること ができ、また、高気孔率、高熱伝導率等の特性が付与さ れる。なお、5質量%未満である場合には、金属珪素の 結合材としての性質が充分に発揮されず、隣接する炭化 珪素粒子同士の金属珪素による結合が不十分となり、熱 伝導率が低下するだけでなく、例えば、ハニカム構造の ような薄壁の構造体を作製した場合、この構造を維持し 得る強度を持たせることが困難となるために好ましくな い。また、50質量%超である場合には、適切に炭化珪 素粒子同士を結合し得る以上に金属珪素が存在すること に起因して、得られる炭化珪素質多孔体が焼結により過 度に収縮してしまい、気孔率低下、気孔径縮小等の弊害 50 が発生する場合もあるために好ましくない。

【0046】 一方、本発明に係るハニカム構造体は、 上述してきた本発明の炭化珪素質多孔体から構成されて いることを特徴としている。当該ハニカム構造体は、そ の構成材料である炭化珪素質多孔体の特性を反映し、優 れた耐酸化性、耐酸性、耐パティキュレート反応性、耐 熱衝撃性を有している。更に、本発明のハニカム構造体 は多孔質構造であるために、ディーゼルエンジンから排 出されるパティキュレートを捕集除去するためのDPF や、触媒担体等として高SV条件下で使用できる。

【0047】 次に、本発明の炭化珪素質多孔体の製造 方法について説明する。本発明の炭化珪素質多孔体を製 造するにあたっては、まず、炭化珪素粒子原料に金属珪 素と有機パインダーとを添加して混合して調合粉を得 る。または、形状をハニカム構造体とする場合には、炭 化珪素粒子原料に金属珪素と有機パインダーとを添加し て混合及び混練し、成形用の坏土を得る。なお、炭化珪 素粒子や金属珪素に用いる原料には、Fe、Alなどの **微量の不純物を含有するケースがあるが、そのまま使用** しても良く、薬品洗浄などの化学的な処理を施して精製 したものを用いてもよい。また、ハニカム構造体をフィ ルターとして使用する場合には、気孔率を高める目的 で、坏土の調合時に造孔剤を添加してもよい。

【0048】 前記調合粉、又は坏土をハニカム形状等 をはじめとする所定の形状に成形し、得られた成形体を 仮焼して成形体中の有機バインダーを除去(脱脂)した 後、不活性ガスの減圧雰囲気下で本焼成を行うことによ り、所定の形状を有する炭化珪素質多孔体を製造する。 即ち、本発明によれば減圧雰囲気下において焼成を行う ために、図1に示すように、炭化珪素粒子1や金属珪素 された炭化珪素質多孔体を得ることができる。

【0049】 酸化皮膜は、炭化珪素粒子と金属珪素と の濡れ性が低下する原因となるため、これを揮発・除去 することによって、炭化珪素粒子と金属珪素との接触面 積を増加させることが可能である。従って、強度や熱伝 導率が向上した炭化珪素質多孔体を製造することができ る。

【0050】 なお、前述の減圧雰囲気とは、焼成する ことによってS i Oz等の酸化皮膜が揮発・除去できる 程度の減圧雰囲気であればよい。具体的には、0.1~ 40 10hPaが好ましく、0.5~5hPaが更に好まし い。0.1hPa未満とすることは設備コスト的に困難 であり、10hPa超とすると、酸化皮膜の揮発が不十 分となるために好ましくない。また、非酸化性雰囲気と するための不活性ガス種についても特に限定されるもの ではないが、入手・取り扱い容易性等の観点から、Ar を用いることが好ましい。

【0051】 次に、本発明に係る炭化珪素質多孔体の 製造方法の別の実施形態を説明する。即ち、前記調合 粉、又は坏土をハニカム形状等をはじめとする所定の形 状に成形し、得られた成形体を仮焼して成形体中の有機 バインダーを除去(脱脂)した後、水素を含有する還元 雰囲気下で本焼成することによって、所定の形状を有す る炭化珪素質多孔体を製造する。

【0052】 図3は、本発明の炭化珪素質多孔体の微 細構造における炭化珪素粒子と金属珪素との接触状態の 更に別の例を説明する模式図であり、炭化珪素粒子1や 金属珪素2の表面にあったSiOュ等の酸化皮膜を還元 的に除去、即ち、SiOzをSiに還元して新たな金属 珪素(被還元金属珪素5)とする。従って、炭化珪素粒 子1と金属珪素2との濡れ性が改善されるために、炭化 珪素粒子1と金属珪素2との接触面積が増加し、強度や 熱伝導率が向上した炭化珪素質多孔体を製造することが できる。

【0053】 なお、本発明において、焼成時の水素含 有率は特に限定されるものではないが、焼成することに よってSiOz等の酸化皮膜が還元的に除去できる程度 の水素含有率であればよい。具体的には、0.5~10 体積%が好ましく、1~4体積%が更に好ましい。0. 5体積%未満では、酸化皮膜の還元的な除去が不十分で あり、10体積%超とすることは、水素ガスの取り扱い が困難となるために好ましくない。

【0054】 また、本発明に係る炭化珪素質多孔体の 製造方法の更に別の実施形態を説明する。即ち、炭化珪 素粒子原料に金属珪素と有機バインダーとともに、金属 元素又はその金属元素を含む化合物を添加して混合して 調合粉を得る。との調合粉又は坏土を、ハニカム形状等 をはじめとする所定の形状に成形し、得られた成形体を 仮焼して成形体中の有機バインダーを除去(脱脂)した 2の表面にあったSiO₂等の酸化皮膜が揮発及び除去 30 後、非酸化雰囲気下で本焼成することによって、所定の 形状を有する炭化珪素質多孔体を製造する。

> 【0055】 即ち、本発明によれば、炭化珪素粒子等 の原料に金属元素、又はその金属元素を含む化合物を添 加するために、酸化皮膜の組成と状態が変化する。従っ て、図3に示すように、炭化珪素粒子1と金属珪素2の 表面は珪酸塩化合物相4によって被覆されるために、炭 化珪素粒子1と金属珪素2との濡れ性が改善され、強度 や熱伝導率が向上した炭化珪素質多孔体を製造すること ができる。

【0056】 とこで、本発明において炭化珪素粒子等 の原料に金属元素、又はその金属元素を含む化合物を添 加した場合の効果について説明する。炭化珪素粒子等の 表面にある酸化皮膜は、焼成時に炭化珪素粒子と金属珪 素の界面からそれぞれの表面に移動する。このとき、酸 化皮膜、即ちSiOュは金属元素と反応してM〇-(Mュ O-、 M_2O- 、…) SiO_2 系 $(M, M_1, M_2, …は一$ 種以上の金属元素を示す。)の化合物を形成し、SiO 」とは異なる相として結晶質、又はガラス状態(非晶) 質) で固定化される。その結果、炭化珪素粒子と金属珪 50 素との濡れ性が向上することとなる。

(8)

【0057】 なお、前記金属元素は、SiOzとの共 融点が1200~1600℃であることが好ましく、1 300~1550℃であることが更に好ましく、135 0~1500℃であることが特に好ましい。1200℃ 未満である場合には、 $MO-(M_1O-M_2O-\dots)$ Si〇、系の融液が金属珪素が溶融する焼成温度付近で 残存せず、焼成時に前述の濡れ性の改善、及び接触面積 拡大効果が発現し難いために好ましくない。一方、16 00℃超である場合には、焼成時にMO(M₁O、M 20、…) とSiO2との反応が十分に進まず、前述の濡 10 い。 れ性の改善、及び接触面積拡大効果が発現し難いために 好ましくない。

13

【0058】 金属元素、金属元素を含む化合物の形態 については特に限定されるものではなく、粉末でも溶液 でもよい。更に、当該金属元素としては、アルカリ土類 金属元素を用いることが好ましく、アルカリ土類金属元 素としては、特にカルシウム、及び/又はストロンチウ ムを用いることが、更なる濡れ性の改善、及び、接触面 積拡大効果の発揮を図るために好ましい。また、カルシ ウムは取り扱いや入手が容易である点においても好まし 20 67

【0059】 金属元素を含む化合物としては、金属元 素のフッ化物、炭化物、塩化物、珪化物、炭酸塩、水酸 化物、酸化物、無機酸塩、有機酸塩を単独で、又はこれ らの混合物を用いることができる。更に、前述の無機酸 塩としては珪酸塩、具体的にはコーディエライト(Mg - Al珪酸塩)、アノーサイト(Ca-Al珪酸塩)を 用いることが好ましい。これらの化合物は安価で入手が 容易であるとともに、得られる炭化珪素質多孔体を、よ り高気孔率、高強度とし、且つ、その熱伝導率をはじめ 30 とする熱的特性を任意に調整することができるために好 ましい。なお、大気中で安定であるとともに、焼成過程 で有毒ガス等が発生しないものが好ましいことはいうま でもなく、炭酸塩、酸化物又は水酸化物も好ましい。

【0060】 なお、本発明の炭化珪素質多孔体の製造 方法においては、仮焼は金属珪素が溶融する温度より低 い温度にて実施することが好ましい。具体的には、15 0~700℃程度の所定の温度で一旦保持しても良く、 また、所定温度域で昇温速度を50℃/hr以下に遅く して仮焼してもよい。また、所定の温度で一旦保持する 手法については、使用した有機バインダーの種類と量に より、一温度水準のみの保持でも複数温度水準での保持 でも良く、更に複数温度水準で保持する場合には、互い に保持時間を同じにしても異ならせてもよい。また、昇 温速度を遅くする手法についても同様に、ある一温度区 域間のみ遅くしても複数区間で遅くしても良く、更に複 数区間の場合には、互いに速度を同じとしても異ならせ てもよい。

【0061】 耐火性粒子が金属珪素で結合された組織

珪素の融点は1410℃であるので、金属珪素のみで結 合された組織を得るためには、1410℃以上で本焼成 することが好ましく、珪酸塩化合物相によっても結合さ れた組織を得るためには、1300℃以上で本焼成する ことが好ましい。また、最適な焼成温度は組織の微構造 や特性値からも決定される。ただし、1600℃を超え る温度では金属珪素の蒸発が進行し、金属珪素を介した 結合が困難になるため、本焼成の温度は1300~16 00℃が適当であり、1350~1550℃が好まし

【0062】 なお、前記の特開平6-182228号 公報に示される再結晶法を用いた製造方法によれば、炭 化珪素粒子同士で結合した構造を有するために高い熱伝 導率の焼結体が得られるが、先に述べたように蒸発凝縮 という機構で焼結するので、炭化珪素を蒸発させるため に、本発明の製造方法よりも高い焼成温度を必要とし、 実用上使用可能な炭化珪素質多孔体を得るためには少な くとも1800℃以上、通常は2000℃以上の高温で 焼成する必要がある。

[0063]

【実施例】 以下、本発明を実施例に基づいて更に詳細 に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるも のではない。

【0064】(実施例1)平均粒径32.6 μmのSi C原料粉末と、平均粒径4μmのSi粉末とを、質量比 で80:20の組成となるように配合し、この粉末10 0 質量部に対して、有機バインダーとしてメチルセルロ ース6質量部、界面活性剤2.5質量部、及び水24質 量部を加え、均一に混合及び混練して成形用の坏土を得 |た。得られた坏土を、押出成形機にて外径45mm、長 さ120mm、隔壁厚さ0.43mm、セル密度100 セル/平方インチ(16セル/cm゚)のハニカム形状 に成形した。

【0065】 とのハニカム成形体を低酸素雰囲気、5 50℃で3時間、脱脂のための仮焼を行った後、2hP aのAr雰囲気において1450℃で2時間の焼成を行 い、多孔質でハニカム構造の炭化珪素質多孔体を作製し た。また、図5に、得られた炭化珪素質多孔体の微細構 造である顕微鏡写真を示す。なお、図中、灰色部分が炭 | 化珪素粒子、白色部分が金属珪素、黒色部分が気孔であ| る。以下、顕微鏡写真に関しては同様である。

【0066】(実施例2)仮焼までは前記実施例1と同 様に行った。得られた仮焼体を、4%の水素を含んだA r雰囲気において1450℃で2時間の焼成を行い、多 孔質でハニカム構造の炭化珪素質多孔体を作製した。ま た、図6に、得られた炭化珪素質多孔体の微細構造であ る顕微鏡写真を示す。

【0067】(実施例3)平均粒径32.6μmのSi C原料粉末と、平均粒径4μmのSi粉末とを、質量比 を得るためには、金属珪素が軟化する必要がある。金属 50 で80:20の組成となるように配合し、この粉末10

〇質量部に対して炭酸カルシウムを1質量%(カルシウ ム換算で0.4質量%)添加し、混合した。更に、この 粉末100質量部に対して、有機パインダーとしてメチ ルセルロース6質量部、界面活性剤2.5質量部、及び 水24質量部を加え、均一に混合及び混練して成形用の 坏土を得た。得られた坏土を、押出成形機にて外径45 mm、長さ120mm、隔壁厚さ0. 43mm、セル密 度100セル/平方インチ(16セル/cm²)のハニ カム形状に成形した。

15

50℃で3時間、脱脂のための仮焼を行った後、Ar雰 囲気において1450°Cで2時間の焼成を行い、多孔質 でハニカム構造の炭化珪素質多孔体を作製した。また、 図7に、得られた炭化珪素質多孔体の微細構造である顕 微鏡写真を示す。

【0069】(実施例4)炭酸カルシウムを1質量% (カルシウム換算で0.4質量%)添加することに代え て、炭酸ストロンチウムを1質量%(ストロンチウム換 算で0.6質量%)添加すること以外は、前記実施例3 と同様の方法により、多孔質でハニカム構造の炭化珪素 20 【0073】 質多孔体を作製した。

【0070】(実施例5)SiC原料粉末と、Si粉末*

*とを質量比で80:20の組成となるように配合するこ とに代えて、SiC原料粉末、Si粉末、及びコーディ エライト(Mg-A1珪酸塩)粉末を、質量比で80: 10:10の組成となるように配合すること以外は、前 記実施例3と同様の方法により、多孔質でハニカム構造 の炭化珪素質多孔体を作製した。

【0071】(比較例1)仮焼までは前記実施例1と同 様に行った。得られた仮焼体を、常圧、Ar雰囲気にお いて1450℃で2時間の焼成を行い、多孔質でハニカ 【0068】 とのハニカム成形体を低酸素雰囲気、5 10 ム構造の炭化珪素質多孔体を作製した。また、図8に、 得られた炭化珪素質多孔体の微細構造である顕微鏡写真 を示す。

> 【0072】(物理特性試験)上記実施例1~3、及び 比較例1において作製した各炭化珪素質多孔体につい て、水銀圧入法にて平均気孔径を測定し、アルキメデス 法により気孔率を測定した。また、所定の試験片を切り 出し、室温条件下において材料試験機を用いた3点曲げ 試験を行い、強度を測定した。更に、レーザーフラッシ ュ法にて熱伝導率を測定した。結果を表1に示す。

【表1】

	平均気孔径	気孔率	強度	熱伝導率	
	(μm)	(%)	(MPa)	(W/mK)	
実施例1	15	53	13	21	
実施例2	15	51	19	17	
実施例3	14	50	23	16	
実施例4	13	49	27	16	
実施例 5	15	48	34	8	
比較例1	7	42	11	14	

【0074】 表1に示すように、実施例1~5の本発 明に係る炭化珪素質多孔体は、比較例1の炭化珪素質多 孔体に比して平均気孔径が大きく、また、高気孔率であ る。更に、実施例1~4の炭化珪素質多孔体は、強度・ 熱伝導率ともに比較例1に比して高いために耐熱衝撃性 に優れているものであり、本発明の優れた効果を確認す ることができた。

【0075】 一方、実施例5の炭化珪素質多孔体は、 実施例1~4の炭化珪素質多孔体と同等の平均細孔径、 気孔率、及び強度でありながらも、熱伝導率が低いもの であることが判る。即ち、実施例5の炭化珪素質多孔体 はMg-Al珪酸塩であるコーディエライトを含むこと に起因して、その熱伝導率が低下したものと考えられ る。従って、使用する材料、及びその組成を調整すると とにより、得られる炭化珪素質多孔体の細孔特性(平均) 細孔径、気孔率等)、機械的特性(強度等)、及び熱的 特性(熱伝導率等)を、用途に応じて適宜制御すること が可能であることが判明した。

【0076】 また、実施例1~3の本発明に係る炭化 50 多孔質のハニカム構造体であるので、自動車排気ガス浄

珪素質多孔体は、図5~7に示すように、炭化珪素粒子 と金属珪素との接触角が鋭角であり、接触面積が広い。 更に、ドメイン同士の間隙によって気孔が形成されてお り、図8に示すような、炭化珪素粒子と金属珪素との接 触角が鈍角である場合に比して、気孔が大径化されてい ることを確認することができた。

[0077]

【発明の効果】 以上説明したように、本発明の炭化珪 40 素質多孔体、及びハニカム構造体は、炭化珪素粒子ので とき耐火性粒子を含みながらも、その製造時において比 較的低い焼成温度で焼結させることができるので、製造 コストを抑えるとともに歩留まりも向上し、安価に提供 することができる。また、所定の微細構造を有している ために、高気孔率、高熱伝導率、及び、高強度といった 特性を有する炭化珪素質多孔体であり、例えばDPFに 使用した場合において、フィルター再生のために堆積し たパティキュレートを燃焼させても、フィルターを損傷 させるような局所的な発熱を生ずることがなく、更に、

化用のフィルターや触媒担体等として高SV条件下でも 好適に使用できる。

17

【0078】 更に、本発明の炭化珪素質多孔体の製造方法は、所定の工程及び条件によって、高気孔率、高熱伝導率であり、且つ、強度向上のなされた炭化珪素質多孔体を安価に製造することができる。

【図面の簡単な説明】

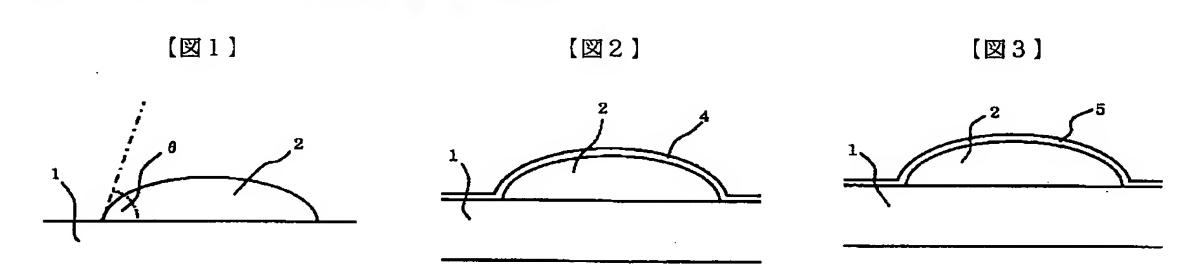
- 【図1】 本発明の炭化珪素質多孔体の微細構造における炭化珪素粒子と金属珪素との接触状態の一例を説明する模式図である。
- 【図2】 本発明の炭化珪素質多孔体の微細構造における炭化珪素粒子と金属珪素との接触状態の別の例を説明する模式図である。
- 【図3】 本発明の炭化珪素質多孔体の微細構造における炭化珪素粒子と金属珪素との接触状態の更に別の例を説明する模式図である。
- 【図4】 従来の炭化珪素質多孔体の微細構造における*

*炭化珪素粒子と金属珪素との接触状態の一例を説明する模式図である。

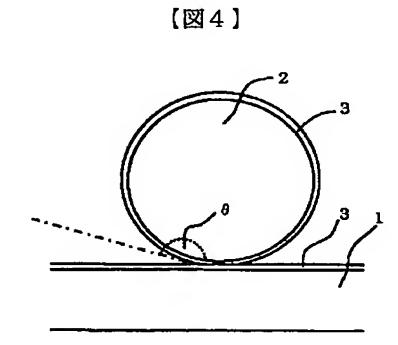
- 【図5】 実施例1 において作製した炭化珪素質多孔体の微細構造である顕微鏡写真である。
- 【図6】 実施例2 において作製した炭化珪素質多孔体の微細構造である顕微鏡写真である。
- 【図7】 実施例3 において作製した炭化珪素質多孔体の微細構造である顕微鏡写真である。
- 【図8】 比較例1 において作製した炭化珪素質多孔体 10 の微細構造である顕微鏡写真である。
 - 【図9】 本発明の炭化珪素質多孔体の微細構造を説明する模式図である。

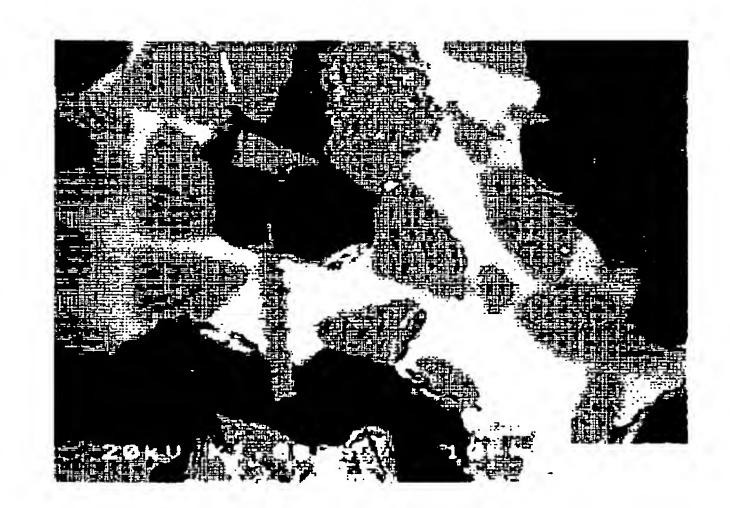
【符号の説明】

1…炭化珪素粒子、2…金属珪素、3…酸化皮膜、4… 珪酸塩化合物相、5…被還元金属珪素、10…気孔、θ …接触角。

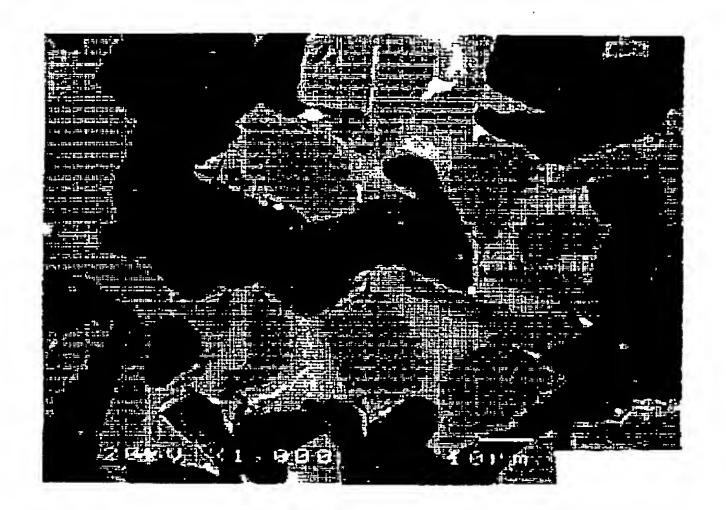


【図5】

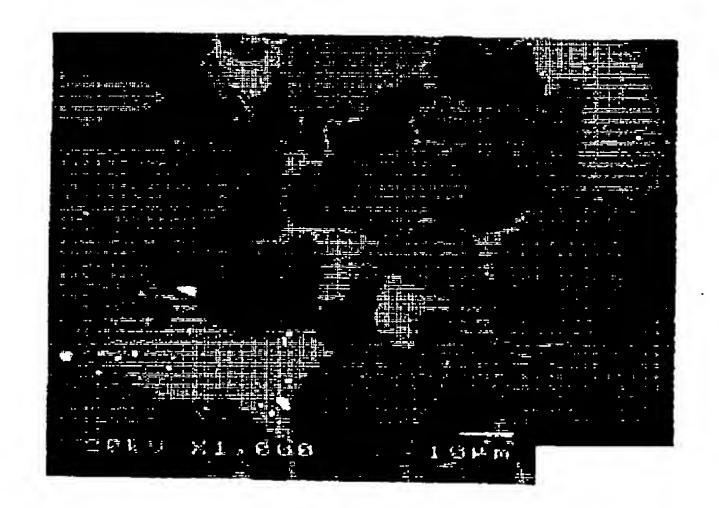




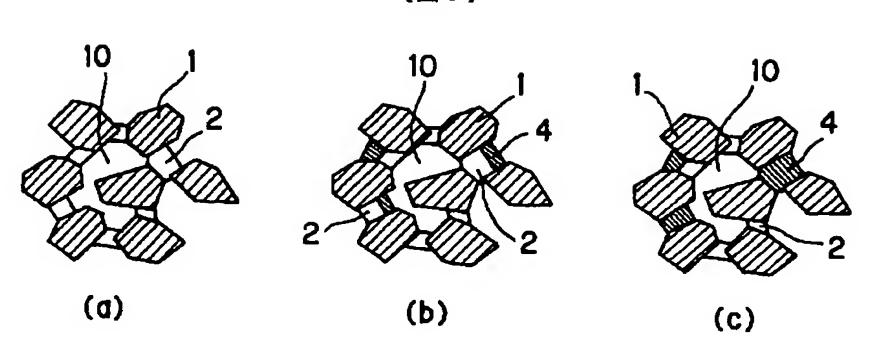
【図6】



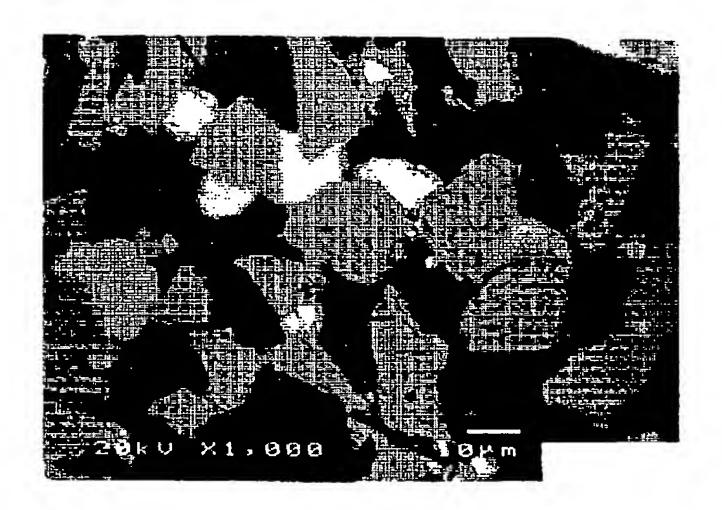
【図7】



【図9】



【図8】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.	" 識別記号	FI	テーマニ	I-ド(参考)
B 0 1 J	27/224	B 0 1 J	32/00	
	32/00		35/04 3 0 1 P	
	35/04 3 0 1	C 0 4 B	35/56 1 0 1 Y	
C 0 4 B	35/565	B 0 1 D	53/36 C	
(72)発明者	市川 周一	F ターム (参	考) 4D019 AA01 BA05 BB06 BC	07 CA01
	愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号 日		CB06	
	本碍子株式会社内		4D048 BA06X BA45X BB02	BB17
(72)発明者	原田節		4G001 BA04 BA05 BA07 BA	22 BA62
	愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号 日		BA65 BB04 BB05 BB	07 BB22
	本碍子株式会社内		BB62 BB65 BC17 BC	26 BC46
			BC52 BC54 BD02 BD	04 BE31
			BE34	
			4G019 FA12 FA13 GA02 GA	04
			4G069 AA01 AA08 BA13B B	B15A
			BB15B BD05A BD05B	CA03
			EA19 EC17Y ED03 FA	A01
			FB33 FB67 FC07	